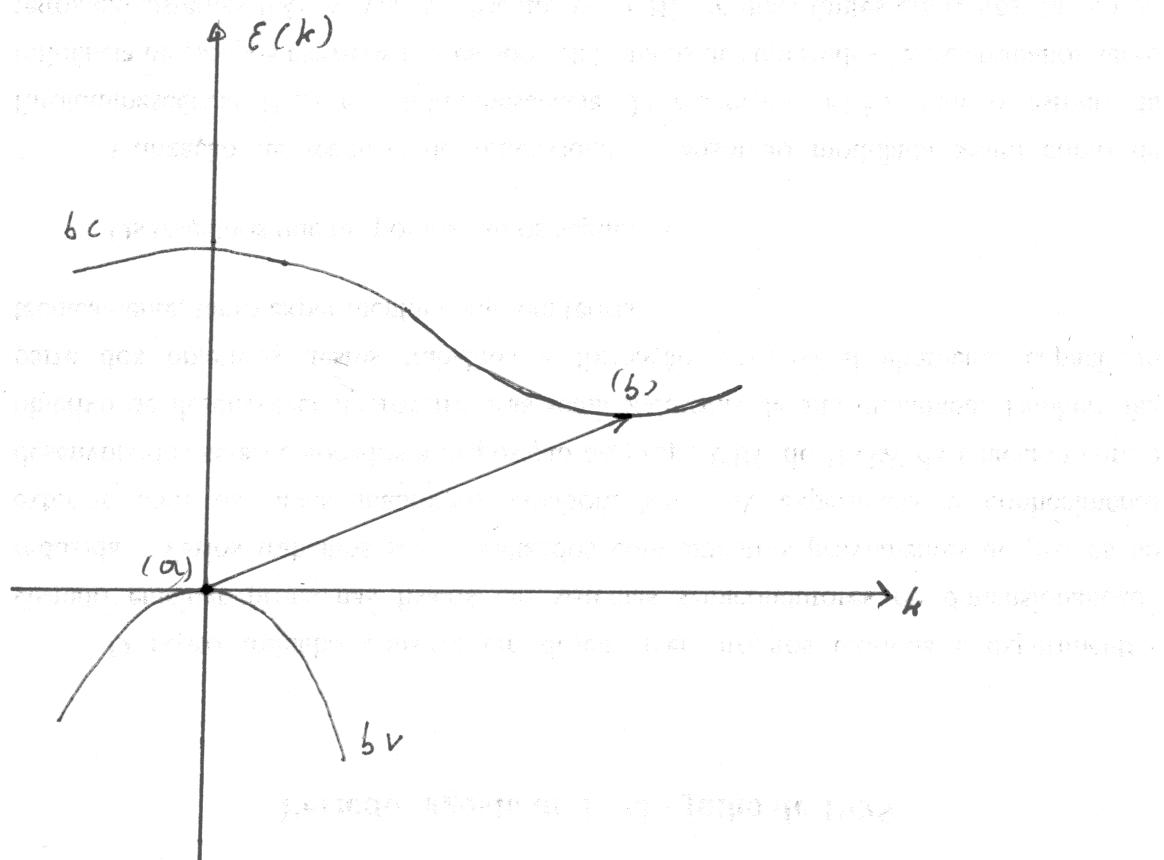


Transições interbandas indiretas

interações eletron-fóton-fóton

Estamos interessados agora no problema da transições ópticas em semicondutores isolantes quando o fóton não tem energia suficiente para a absorção direta (se permitida pelas regras de seleção).



Vamos considerar transições onde o fóton tem energia próxima ao gap indireto.

Para o cristal estático, esta transição não é (2) possível. Se relaxarmos esta aproximação e permitirmos o cristal vibrar, é possível para o elétron trocar momento com a rede e realizar a transição. Mesmo a 0 K pode-se emitir um fôton e, portanto, a transição é realizável. Para altas temperaturas, a presença de uma população de fôtons torna a transição mais provável.

Consideremos as soluções do cristal não-perturbado:

$$H_0 \Psi_n = E_n \Psi_n$$

(1)

Para o cristal perturbado, temos de resolver

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (H_0 + H') \Psi \quad (2.a)$$

onde

$$i\hbar \frac{d \Psi_m}{dt} = \sum_{n=1}^N V_{mn} [e^{i(\omega_m + \omega)t} + e^{i(\omega_m - \omega)t}] \quad (2.b)$$

e

$$V_{mn} = \int \Psi_m^* H'(F) \Psi_n dF \quad (3)$$

Em primeira ordem em teoria de perturbações, temos

$$i\hbar \frac{d \Psi_m}{dt} = V_{mo} [e^{i(\omega_m + \omega)t} + e^{i(\omega_m - \omega)t}] \quad (4)$$

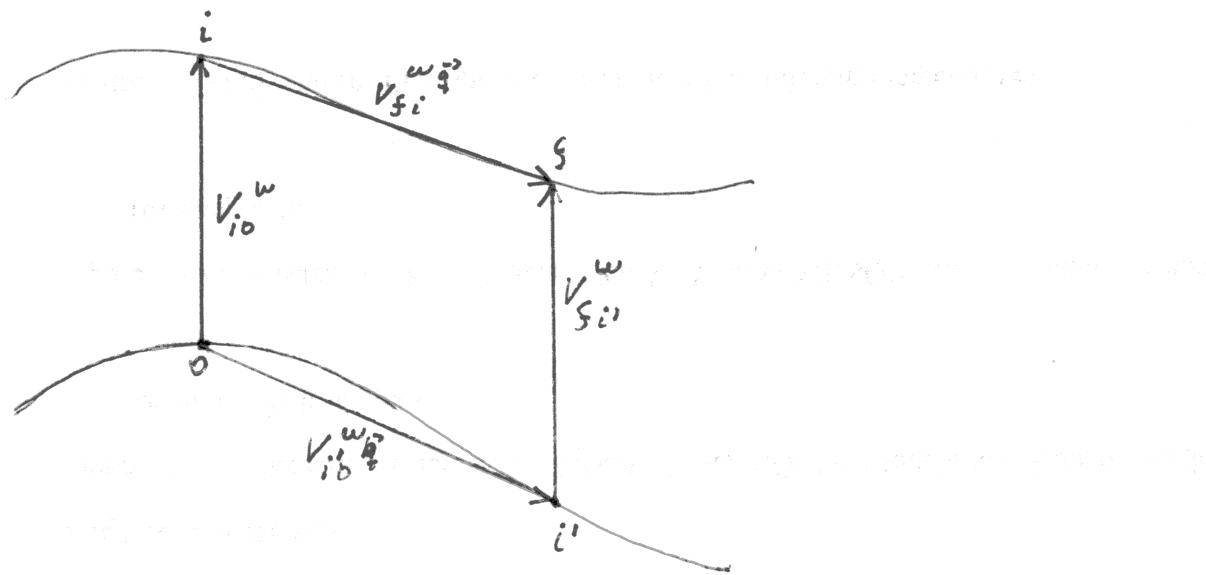
com o sistema inicialmente no estado fundamental. (3)

Como a transição que estamos discutindo envolve um fôton e um fônon, ela deve ser realizada em duas etapas. Nas estanças interessantes em transições envolvendo fôtons que permitem a transição direta. Podemos então descrever o coeficiente "a₀" na expansão (2.5).

Utilizando segunda ordem, temos

$$i\hbar \frac{da_m^{(2)}}{dt} = \sum_{n \neq 0} a_n^{(1)} V_{mn} [e^{i(\omega_m - \omega_n)t} + e^{i(\omega_m + \omega_n)t}] \quad (15)$$

Vamos considerar a transição como sendo em duas etapas: a) absorção de energia pelo ^a~~abrilha~~ fôton e b) conservação de momento, $\hbar k$, por emissão ou absorção de fônon. Consideraremos apenas transições envolvendo um fônon.



(4)

O Hamiltoniano de interação pode ser escrito sob a forma

$$H' = \frac{1}{2} A^{\text{fóton}} [e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}] + \frac{1}{2} V^{\text{fóton}} [e^{i\omega_g t} + e^{-i\omega_g t}] \quad (16)$$

onde $A^{\text{fóton}}$ é o operador eletro-fóton que consideramos nas transições elétricas e $V^{\text{fóton}}$ é o operador fóton-eletrão que consideramos nos problemas de espinamento.

Pode-se definir

$$V_{mn}^{\omega} = \int \psi_m^* \left(\frac{1}{2} A^{\text{fóton}} \right) \psi_n dt \quad (7.a)$$

$$V_{mn}^{\omega_g} = \int \psi_m^* \left(\frac{1}{2} V^{\text{fóton}} \right) \psi_n dt \quad (7.b)$$

O termo de primeira ordem é, integrando a Eq. 4,

$$\alpha_n^{(1)} = \frac{V_{n0}^{\omega}}{t} \left\{ \frac{1 - e^{i(\omega_{n0} - \omega)t}}{\omega_{n0} - \omega} \right\} + \frac{V_{n0}^{\omega_g}}{t} \left\{ \frac{1 - e^{i(\omega_{n0} + \omega_g)t}}{\omega_{n0} + \omega_g} \right\} \quad (8)$$

onde não incluímos o termo correspondente à emissão de um fóton.

Se considerarmos apenas os estados intermediários i e i' , temos, em segunda ordem,

$$i\hbar \frac{d\alpha_f}{dt} = a_i^{(1)} V_{si}^w V_{i'j'}^{w_g} [e^{i(w_{si} + w_g)t} + e^{i(w_{si} - w_g)t}] + \\ + a_{i'}^{(1)} V_{s'i'}^w V_{i'j'}^{w_g} e^{i(w_{s'i'} - w)t} \quad (9)$$

onde, novamente, o termo em $w_{si} + w$ não foi incluído por corresponder a emissão de um fóton.

Substituindo a Eq. 8 em 9 e ignorando apenas os termos de interesse, temos

$$i\hbar \frac{d\alpha_f^{(2)}}{dt} = V_{si}^w V_{i'0}^w \left\{ e^{i(w_{si} + w_g)t} - e^{i(w_{si} + w_g + w_{i'0} - w)t} \right\} + \\ + \frac{V_{s'i'}^w V_{i'0}^{w_g}}{t} \left\{ e^{i(w_{s'i'} - w)t} - e^{i(w_{s'i'} - w + w_{i'0} + w_g)t} \right\} \quad (10)$$

Os termos em $(w_{si} + w_g)$ e $(w_{s'i'} - w)$ não serão considerados pois envolvem transições diretas e nós estamos considerando situações onde a transição direta é energeticamente impossível.

(6)

Escrevendo,

$$\omega_{si} + \omega_{io} = \omega_{sii} + \omega_{iio} = \omega_{so} \quad (11)$$

e Eq. 10 forma - 8,

$$i\hbar \frac{d\alpha_f^{(2)}}{dt} = - \frac{V_{si}^{\omega} V_{io}^{\omega}}{\hbar(\omega_{io} - \omega)} e^{i(\omega_{so} \pm \omega_g - \omega)t}$$

$$- \frac{V_{sii}^{\omega} V_{iio}^{\omega}}{\hbar(\omega_{iio} \pm \omega_g)} e^{i(\omega_{so} \pm \omega_g - \omega)t} \quad (12)$$

Pela conservação de energia total,

$$\omega = \omega_{so} \pm \omega_g = \omega_{sii} + \omega_{iio} \pm \omega_g$$

$$\Rightarrow \omega_{iio} \pm \omega_g = \omega - \omega_{sii} \quad (13)$$

e integrando de $t=0$ à t ,

$$\alpha_f^{(2)} = \left[\frac{V_{si}^{\omega} V_{io}^{\omega}}{\hbar^2(\omega_{io} - \omega)} + \frac{V_{sii}^{\omega} V_{iio}^{\omega}}{\hbar^2(\omega - \omega_{sii})} \right] \left\{ \frac{\exp[i(\omega_{so} \pm \omega_g - \omega)t] - 1}{\omega_{so} \pm \omega_g - \omega} \right\} \quad (14)$$

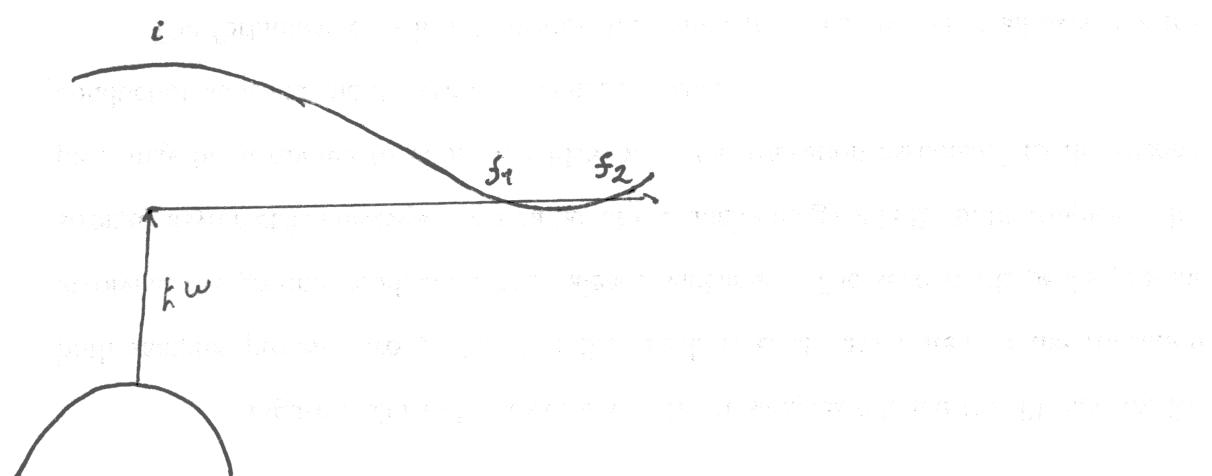
A probabilidade de encontrar o elétron no estado

"s" é $|\alpha_f^{(2)}|^2$. Desprezando os termos cruzados (que são feitos para transições diretas; eles produzem termos rapidamente oscilantes), e desprezando escrevendo os termos exponenciais

(7) que fornecerá termos de tipo $\frac{\sin^2 \tilde{z}^*}{\omega^2} \text{ut}$. em funções de para a conservação da energia e, ainda, lembrando que a probabilidade de transição é a desejada temporal de $|\alpha_f^{(2)}|^2$, temos

$$N_{f_0} = \frac{2\pi |V_{S_i} \tilde{\omega}_g|^2 / V_{i_0} \omega|^2}{k^4 (\omega_{i_0} - \omega)^2} [\delta(E_{f_0} - h\tilde{\omega}_g - \hbar\omega) + \delta(E_{f_0} + h\tilde{\omega}_g - \hbar\omega)] + \frac{2\pi |V_{S_i} \omega|^2 / V_{i_0} \tilde{\omega}_g|^2}{k^4 (\omega - \omega_{f_0})^2} [\delta(E_{f_0} - h\tilde{\omega}_g - \hbar\omega) + \delta(E_{f_0} + h\tilde{\omega}_g - \hbar\omega)] \quad (15)$$

O primeiro termo nos dá a transição entre os estados "0" e "f" via uma transição direta no estado intermediário "i" e uma transição ~~final~~ dos estados final "f" por absorção de um fôton:



Neste caso, $V_{S_i} \tilde{\omega}_g$ é diferente de zero se $\tilde{\omega}(\text{eletron}) = \tilde{\omega}(\text{fôton})$ e a energia total da transição é conservada.

(8)

Se considerarmos agora a transição entre um grupo de estados em "S" e um grupo de estados em "F", via absorção de fôtons,

$$W = \frac{2\pi |V_{Si}|^2 / V_{io}^u|^2}{\epsilon^4 (w_{io} - \omega)^2} \int_0^{\hbar w + \hbar w_g - E_g} P_V(\epsilon - \hbar w - \hbar w_g) P_C(\epsilon) d\epsilon \quad (16)$$

onde $|V_{Si}|^2$ é uma medida do elemento da matriz óptica.

Para bandas parabólicas,

$$\begin{aligned} W &\propto |V_{Si}|^2 / V_{io}^u|^2 \int_0^{\hbar w + \hbar w_g - E_g} (\hbar w + \hbar w_g - E_g)^{1/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \propto \\ &\propto |V_{Si}|^2 / V_{io}^u|^2 (\hbar w + \hbar w_g - E_g)^2 \end{aligned} \quad (17)$$

A probabilidade de absorção de um fôton é proporcional à densidade n_g :

$$|V_{Si}|^2 \propto n_g = \frac{1}{e^{\hbar w_g / k_B T} - 1} \quad (18)$$

O resultado final é

(9)

$$\alpha_{ab} \propto \frac{(h\nu + h\nu_g - E_g)^2}{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}} - 1} \quad (119)$$

para a absorção, e

$$\alpha_{em} = \frac{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}}}{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}} - 1} (h\nu - h\nu_g - E_g)^2 \quad (20)$$

Os resultados acima só são possíveis se a transição
seja permitida pela simetria do problema.
Caso contrário, temos de utilizar o segundo termo da Eq. 15.

O resultado final é,

$$\alpha_{ab} \propto \frac{(h\nu + h\nu_g - E_g)^3}{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}} - 1} \quad (20.a)$$

$$\alpha_{em} \propto \frac{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}}}{e^{\frac{h\nu_g/k_B T}{}} - 1} (h\nu - h\nu_g - E_g)^3 \quad (20.b)$$

(10)

A conservação do momento é necessária para cada etapa da transição. No entanto, a conservação de energia só é necessária para a transição total. Nas etapas intermediárias, isto não se verifica (assim como processos de segunda ordem). Isto é possível graças ao princípio de incerteza. O tempo de vida dos estados intermediários,

$$\tilde{T}_i \approx \frac{\hbar}{|\varepsilon_0 - \hbar\omega|} \quad (21)$$